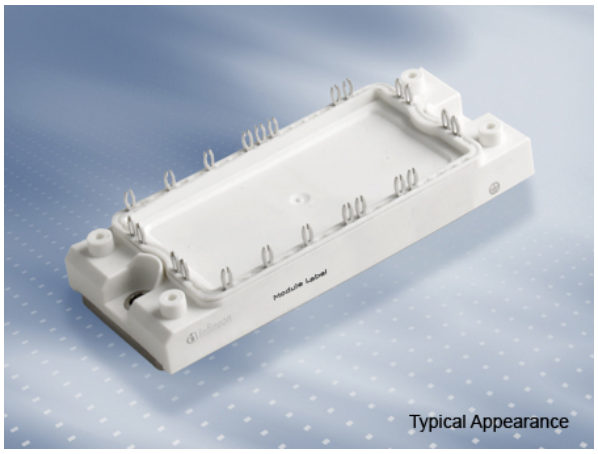
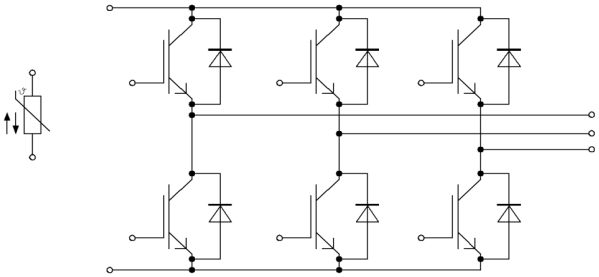
EconoPACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC / TIM

EconoPACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC / TIM





V_{CES} = 1200V
$I_{C\ nom}$ = 50A / I_{CRM} = 100A

Typische Anwendungen
- Hilfsumrichter
- Motorantriebe
- Servoumrichter

Typical Applications
- Auxiliary inverters
- Motor drives
- Servo drives

Elektrische Eigenschaften
- Niedriges V_{CEsat}
- $T_{vj\ op}$ = 150°C
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten

Electrical Features
- Low V_{CEsat}
- $T_{vj\ op}$ = 150°C
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

Mechanische Eigenschaften
- Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Hohe Last- und thermische Wechselfestigkeit
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- Kupferbodenplatte
- PressFIT Verbindungstechnik
- Standardgehäuse
- Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

Mechanical Features
- Al_2O_3 substrate with low thermal resistance
- High power and thermal cycling capability
- Integrated NTC temperature sensor
- Copper base plate
- PressFIT contact technology
- Standard housing
- Pre-applied Thermal Interface Material

Module Label Code

Barcode Code 128

Sample
000001234560000000000000

DMX - Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_H = 85°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C	$I_{C\,nom}$	50	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V T_{vj} = 25°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V T_{vj} = 125°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V T_{vj} = 150°C	$V_{CE\,sat}$		1,85 2,15 2,25	2,15	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 1,60 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,20	5,80	6,40	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,38		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		4,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		2,80		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,10		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	$t_{d\,on}$		0,13 0,15 0,15		µs µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	t_r		0,02 0,03 0,035		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	$t_{d\,off}$		0,30 0,38 0,40		µs µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	t_f		0,045 0,08 0,09		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 25 nH T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, di/dt = 1300 A/µs (T_{vj} = 150°C) T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	E_{on}		4,50 6,40 7,40		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 25 nH T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, du/dt = 3800 V/µs (T_{vj} = 150°C) T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 15 Ω T_{vj} = 150°C	E_{off}		2,50 4,10 4,50		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 800 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		180		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT valid with IFX pre-applied thermal interface material	R_{thJH}			0,671	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	560	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 125°C I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 150°C	V_F		1,70 1,65 1,65	2,15	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 50 A, - di_F/dt = 1300 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	I_{RM}		70,0 75,0 77,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 50 A, - di_F/dt = 1300 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	Q_r		5,10 9,30 10,0		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 50 A, - di_F/dt = 1300 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	E_{rec}		1,70 3,20 3,60		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface material	R_{thJH}			0,887	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	T_{NTC} = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R100 Deviation of R100	T_{NTC} = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	T_{NTC} = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/100}$		3433		K

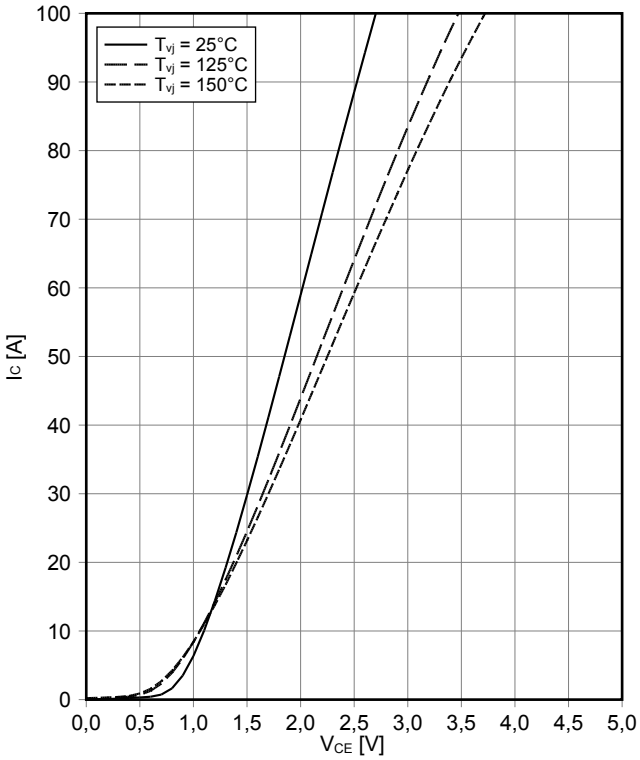
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Modul / Module

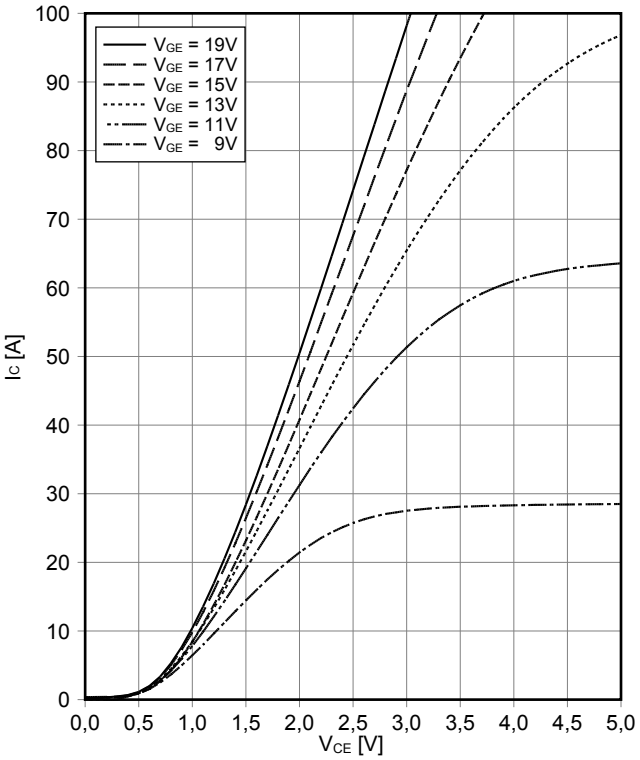
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate				Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 200		
			min.	typ.	max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,02		K/W
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		19		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T_H = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$		1,80		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur Maximum baseplate operation temperature		T_{BPmax}			125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00	Nm
Gewicht Weight		G		180		g

Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

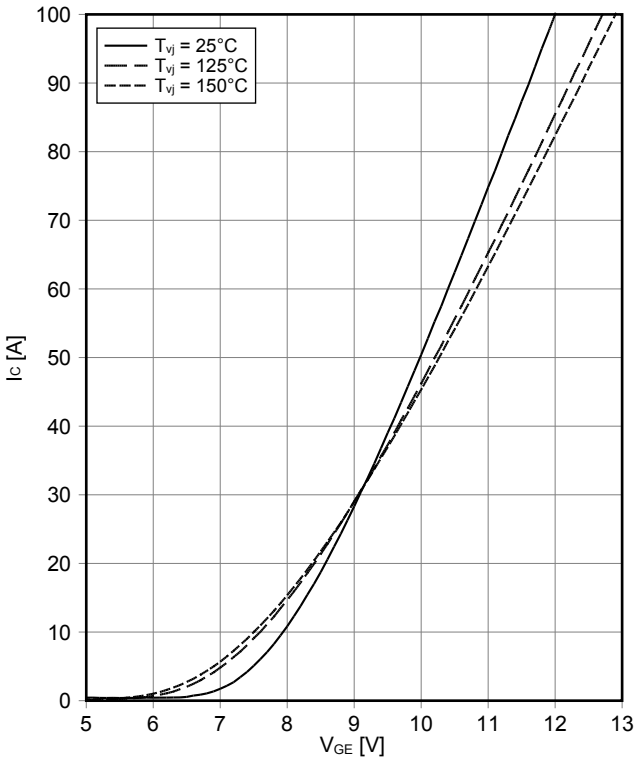
Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



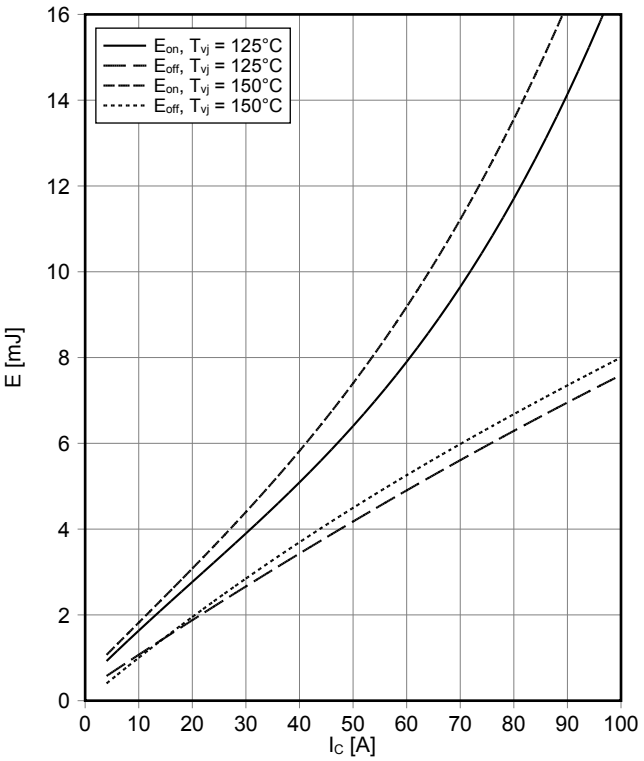
Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150°C



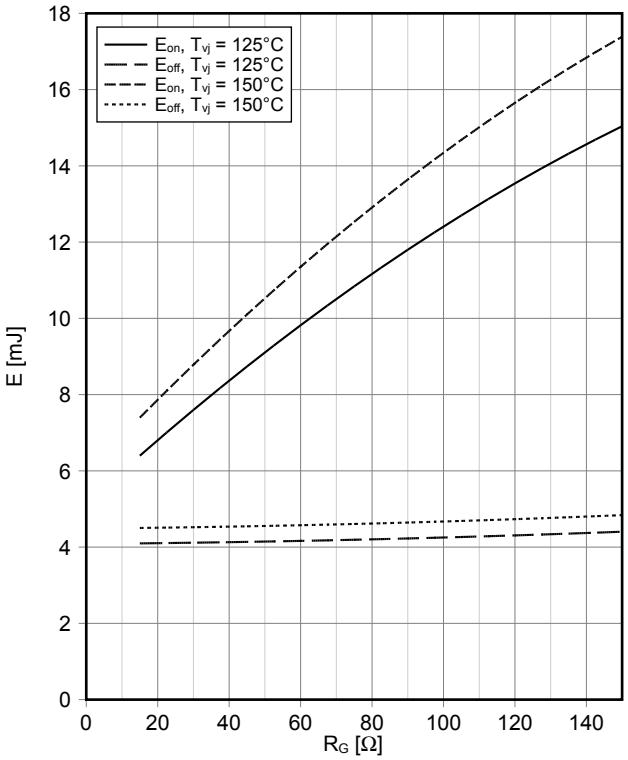
Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



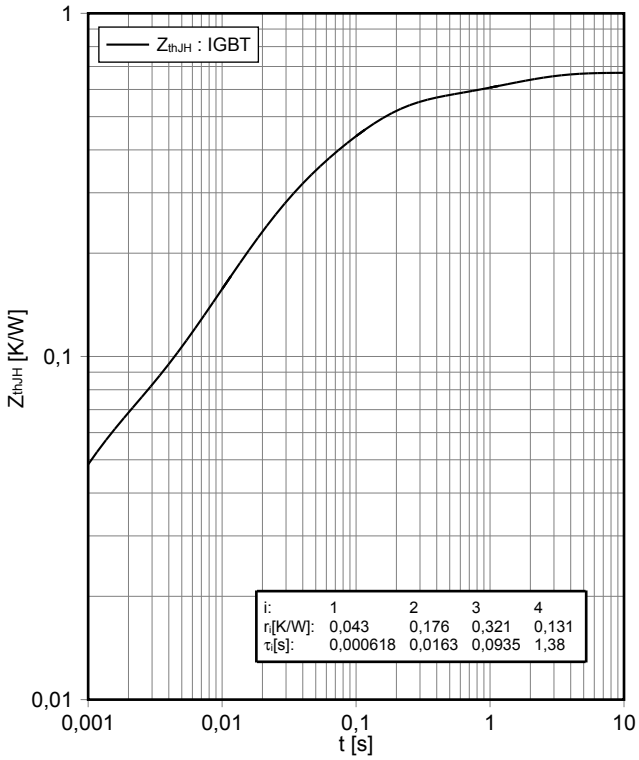
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 15 Ω, R_{Goff} = 15 Ω, V_{CE} = 600 V



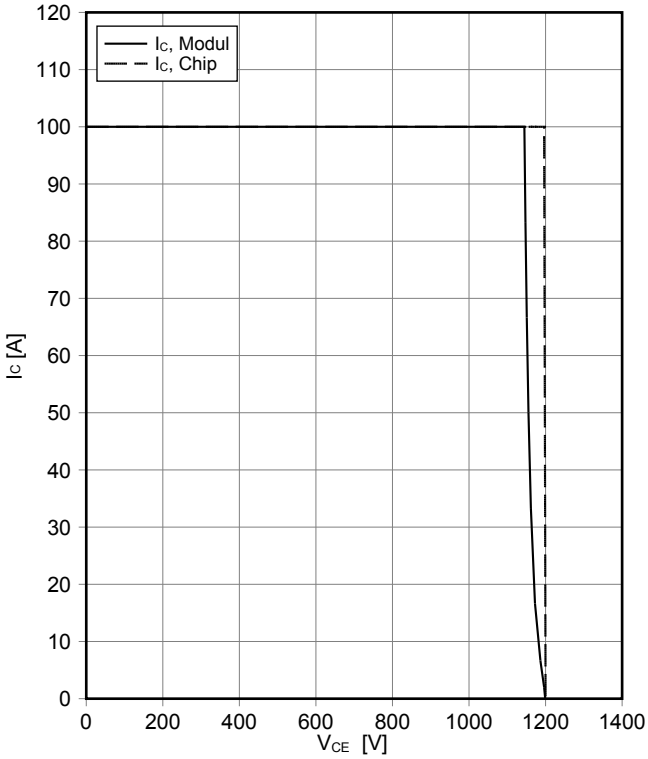
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 50 A, V_{CE} = 600 V



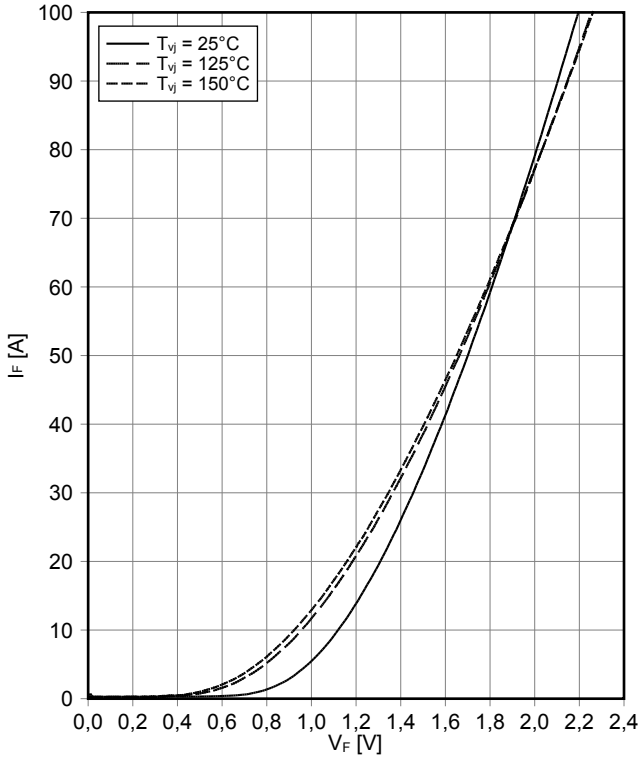
Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT,Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



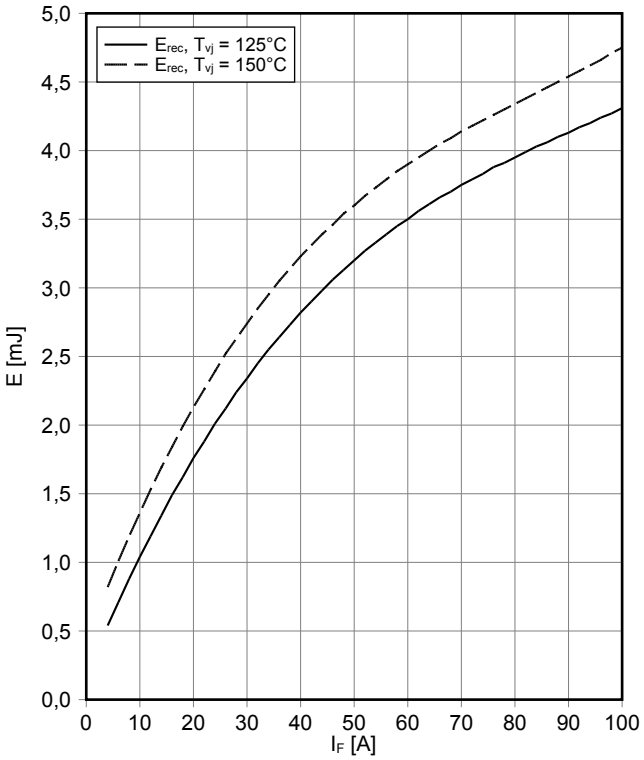
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT,Wechselrichter (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 15 Ω, T_{vj} = 150°C



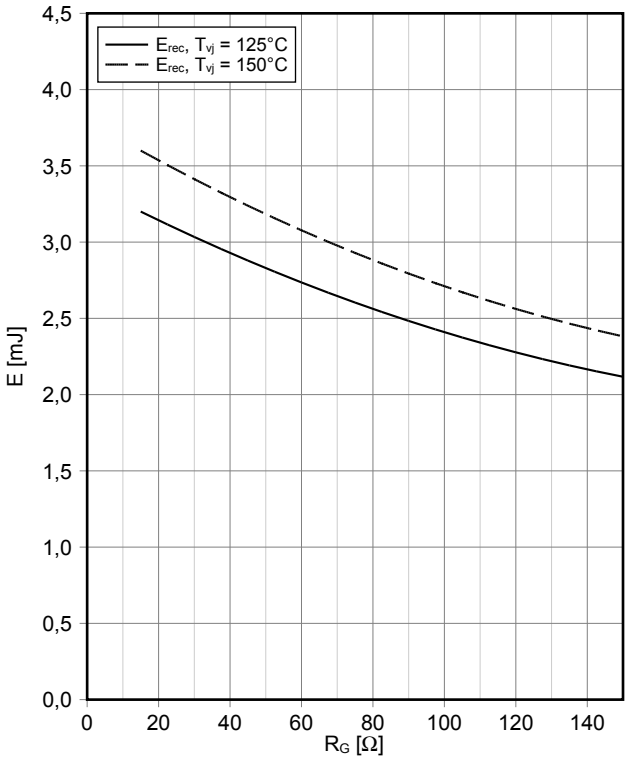
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



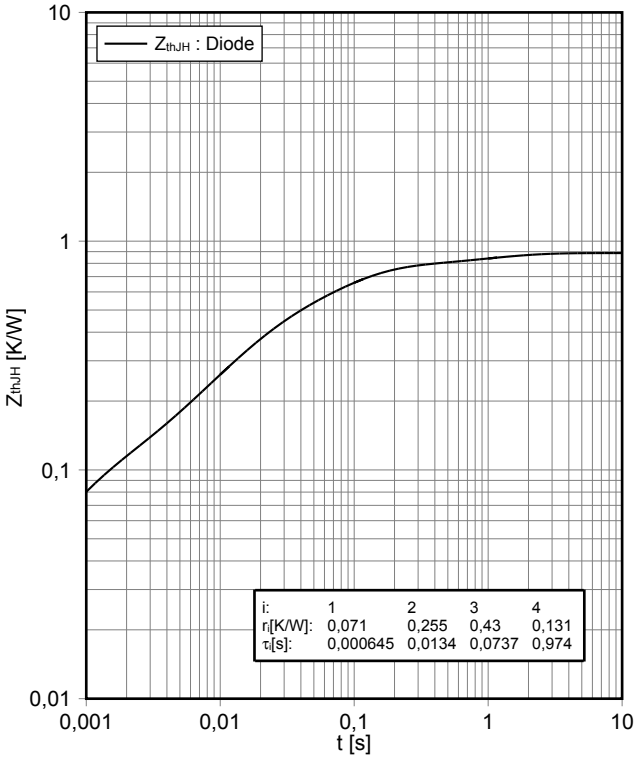
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 15\ \Omega$, $V_{CE} = 600\ V$



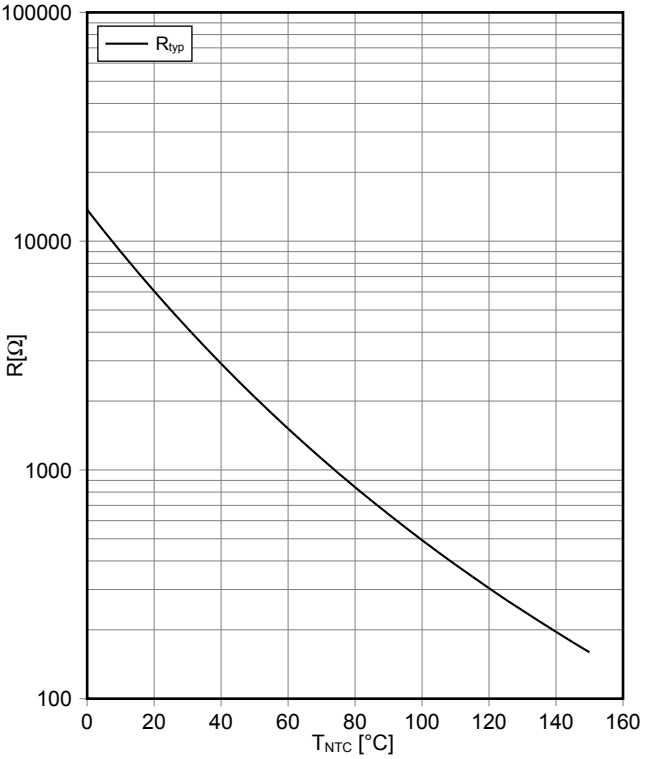
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 50\ A$, $V_{CE} = 600\ V$



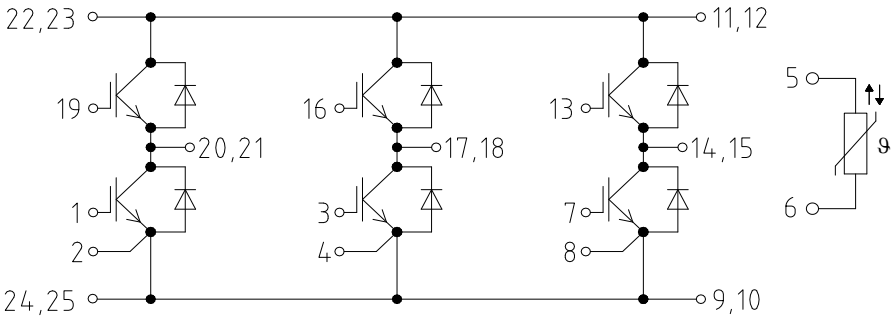
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter
transient thermal impedance Diode, Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



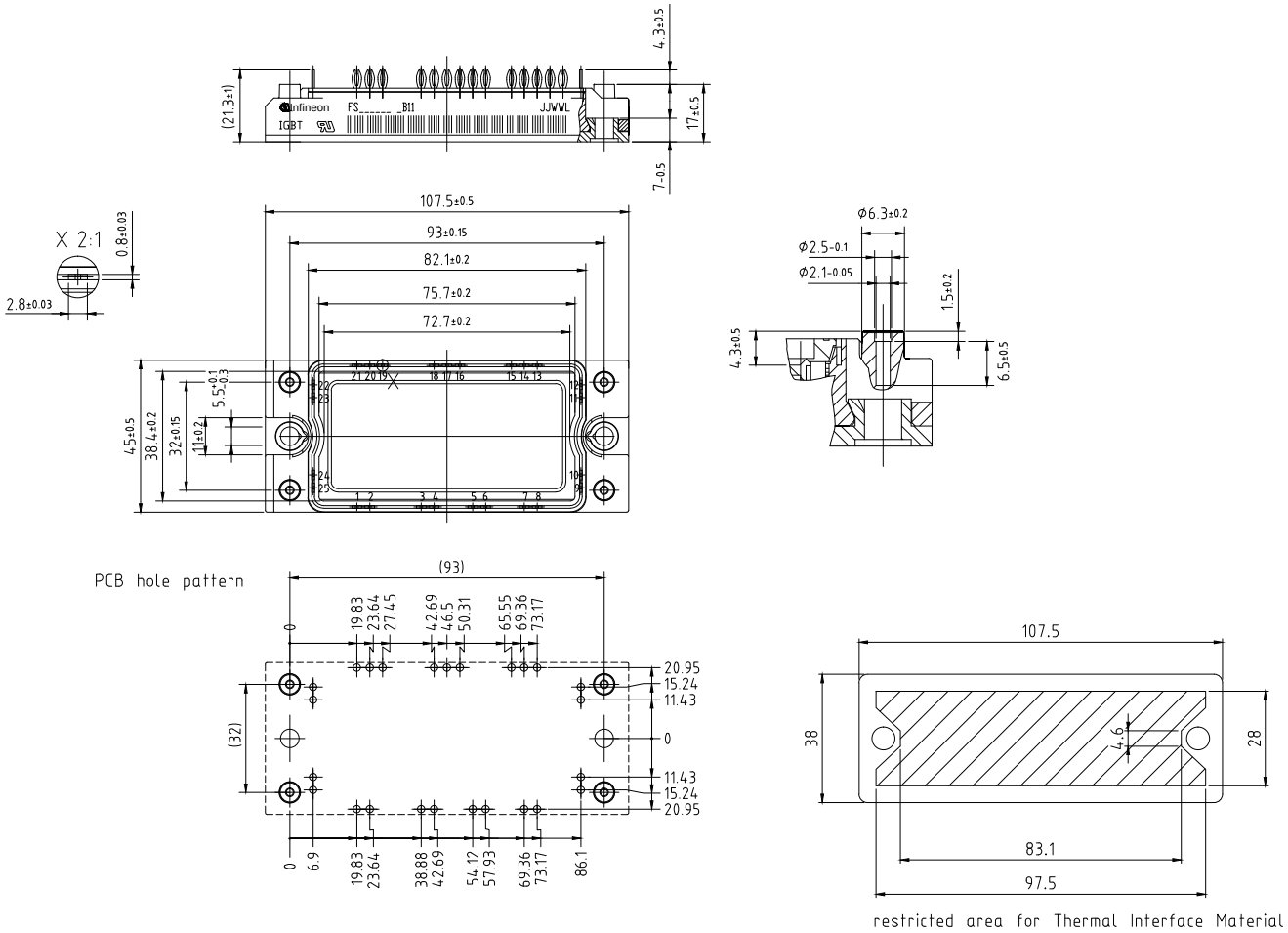
NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
R = f (T)



Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



- Tolerance of PCB hole pattern ⌖ Ø0.1
- hole specifications see AN 2007-09
- Diameters of plated holes Ø 2.14mm - 2.29mm
- Diameter of drill Ø 2.35mm

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2017-08-08

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany

© 2017 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Infineon Technologies:

BGM781N11E6327XUSA1 TLF80511TCATMA2 AIMW120R060M1HXKSA1 IPD60R650CEAUMA1 BAT5405WH6327XTSA1 CY8C24894-24LTXI FS75R12KE3B9BOSA1 IRF3710PBF IKD10N60RFATMA1 IPL60R185C7AUMA1 ISZ75DP15LMATMA1 BSZ050N03LSGATMA1 BTS 5210 G BTS70302EPADAUGHBRDTOBO1 FP150R12N3T4PB81BPSA1 FS100R12KT4GPBPSA1 IM241S6S1BAUMA1 IPB320P10LMATMA1 IPT014N08NM5ATMA1 2EDS8265HXUMA2 EVALPMG1B1DRPTOBO1 TC1782F320F180HRBAKXUMA2 TLE493DW2B6A0HTSA1 TLE4971A120N5E0001XUMA1 BSC320N20NS3 G IGCM10F60GAXKMA1 SPP06N80C3 XMC4800F144K1024AAXQMA1 CY8C29466-24PVXI TLS208D1EJV33XUMA1